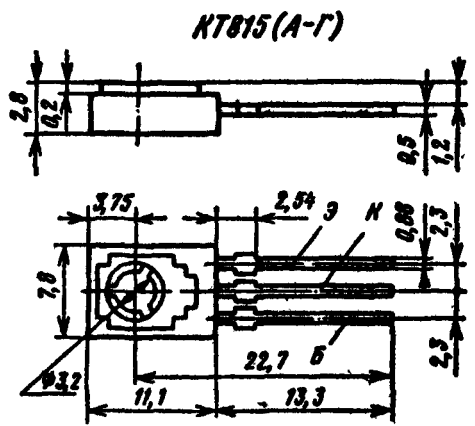


Транзисторы кремниевые меза-эпителиально-планарные структуры *n-p-n* усилительные. Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, операционных и дифференциальных усилителях, преобразователях, импульсных устройствах. Корпус пластмассовый с жесткими выводами.

Масса транзистора не более 1 г.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{кэ}=2$  В,  $I_k=0,15$  А, не менее:

$T = +25^\circ \text{C}$ :	КТ815А, КТ815Б, КТ815В	40
	КТ815Г	30
$T = -40^\circ \text{C}$ :	КТ815А, КТ815Б, КТ815В	30
	КТ815Г	20

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{кэ}=5$  В,  $I_b=0,03$  А, не менее . . . . . 3 мГц .

Граничное напряжение при  $I_b=50$  мА,  $t_u=300$  мкс,  $Q \geq 100$ , не менее:

КТ815А	25 В
КТ815Б	40 В
КТ815В	60 В
КТ815Г	80 В

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при  $I_k=0,5$  А,  $I_b=0,05$  А, не более . . . . . 0,6 В  
 типовое значение . . . . . 0,2\* В

Напряжение насыщения база — эмиттер при  $I_k=0,5$  А,  $I_b=0,05$  А, не более . . . . . 1,2 В

Обратный ток коллектора при  $U_{кэ}=40$  В, не более: . . . . . 50 мкА  
 $T_n = -40 \dots +25^\circ \text{C}$

$T_n = +100^\circ \text{C}$  . . . . . 1000 мкА

Входное сопротивление в режиме малого сигнала при  $U_{кэ}=5$  В,  $I_k=5$  мА,  $f=800$  Гц, не менее . . . . . 800 Ом

Емкость коллекторного перехода при  $U_{кэ}=5$  В,  $f=465$  кГц, не более . . . . . 60 пФ

Емкость эмиттерного перехода при  $U_{эб}=0,5$  В, не более . . . . . 75 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер:

$R_{сэ} \leq 100$ Ом:	КТ815А	40 В
	КТ815Б	50 В
	КТ815В	70 В
	КТ815Г	100 В

$R_{сэ} = \infty$ :	КТ815А	25 В
	КТ815Б	40 В
	КТ815В	60 В
	КТ815Г	80 В

Постоянное напряжение база — эмиттер . . . . . 5 В

Постоянный ток коллектора . . . . . 1,5 А

Импульсный ток коллектора при  $t_u \leq 10$  мс,  $Q \geq 100$  . . . . . 3 А

Постоянный ток базы . . . . . 0,5 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора<sup>1</sup> при  $T_n = -40 \dots +25^\circ \text{C}$ :

с теплоотводом . . . . . 10 Вт

без теплоотвода . . . . . 1 Вт

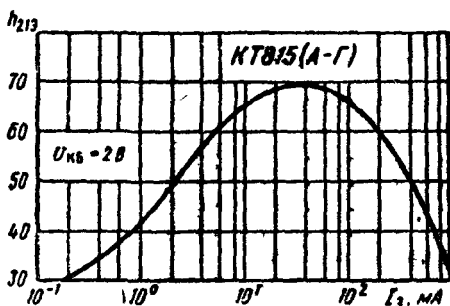
Температура *p-n* перехода . . . . .  $+125^\circ \text{C}$

Температура окружающей среды . . . . .  $-40^\circ \text{C} \dots T_n = +100^\circ \text{C}$

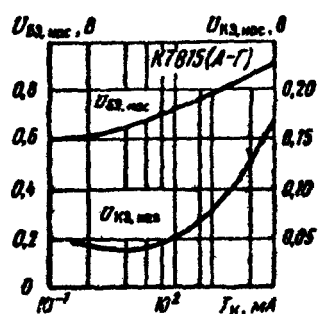
<sup>1</sup>  $P_{к, макс}$  снижается линейно на 0,1 Вт/°С с теплоотводом и на 0,01 Вт/°С без теплоотвода.

Изгиб выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5...2 мм; при этом должны приниматься меры, исключающие возможность передачи усилий на корпус. Изгиб в плоскости выводов не допускается.

Пайка выводов транзисторов рекомендуется не ближе 5 мм от корпуса путем погружения выводов не более чем на 2 с в расплавленный припой температурой не выше  $+250^\circ \text{C}$ .



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимости напряжений насыщения коллектор — эмиттер и база — эмиттер от тока коллектора